

Фамилия, имя, отчество	Алексянн Луиза Араратовна
Должность, ученая степень, ученое звание	Ассистент, к.ф.-м.н.
Электронная почта	laleksanian@misis.ru
Область научных интересов	Светодиоды на основе нитрида галлия, микро- и наносветодиоды, широкозонные полупроводники, оксид галлия, силовая электроника
Трудовая деятельность	НИТУ МИСИС с 2017 г.
Образование Дополнительное образование	Высшее образование: - 2014-2018 гг. Бакалавриат, НИТУ МИСИС - 2018-2020 гг. Магистратура, НИТУ МИСИС - 2020-2024 гг. Аспирантура, НИТУ МИСИС - 2024 г. Кандидат наук Дополнительное образование: - 2023 г. Профессиональная переподготовка, Математическое моделирование МРЭСVD процессов для синтеза алмазных материалов, НИТУ МИСИС - 2025 г. Повышение квалификации, Оформление отчетов о НИР и ВКР по ГОСТ 7.32-2017, НИТУ МИСИС
Значимые исследовательские/преподавательские проекты, гранты (тема, заказчик, год, полученные результаты)	- Грант РФФИ №19-19-00409 «Исследование электрически активных точечных и протяженных дефектов в новом широкозонном полупроводнике α- и β-Ga₂O₃, гетероструктурах и мембранах на их основе» (2019 г. - 2021 г., продлен на 2022 - 2023.) - Грант Министерства науки и высшего образования № 075-15-2022-1113 «Новые радиационные явления в оксиде галлия и их применение в радиационных приборах» (2022 г. - 2024 г.)
Значимые публикации (список, не более 10)	1. Polyakov A. Y., Haller C., Smirnov N. B., Shiko A. S., Shchemerov I. V., Chernykh S. V., Alexanyan L. A., Lagov P. B., Pavlov Yu. S., CARLIN J., Mosca M., Butté R., Grandjean N., Pearton S. J. Effects of InAlN underlayer on deep traps detected in near-UV InGaN/GaN single quantum well light-emitting diodes // Journal of Applied Physics. 2019. Vol. 126. No. 12. p. 125708.

	2. Lee I., Kim T., Polyakov A. V., Chernykh A. M., Skorikov M. L., Yakimov E. B., Alexanyan L. A., Shchemerov I. V., Vasilev A., Pearton S. J. Degradation by sidewall recombination centers in GaN blue micro-LEDs at diameters // Journal of Alloys and Compounds. 2022. Vol. 921. p. 166072. 3. Polyakov A. V., Shcherbachev K. D., Saranin D. S., Chernykh A. M., Vasilev A., Gostishchev P., Kochkova A. I., Alexanyan L. A., Matros N. R., Shchemerov I. V., Pearton S. J. Trap states and carrier diffusion lengths in NiO/β-Ga₂O₃ heterojunctions // Journal of Applied Physics. 2024. Vol. 135. No. 16. 165703 4. Polyakov A. V., Shmidt N. M., Smirnov N. B., Shchemerov I. V., Shabunina E. I., Tal'nishnih N. A., Lagov P. B., Pavlov Y. S., Alexanyan L. A., Pearton S. J. Defect States Induced in GaN-Based Green Light Emitting Diodes by Electron Irradiation // ECS Journal of Solid State Science and Technology. 2018. Vol. 7. No. 6. p. P323-P328. 5. Polyakov A. Y., Shmidt N. M., Smirnov N. B., Shchemerov I. V., Shabunina E. I., Tal'nishnih N. A., Lee I., Alexanyan L. A., Tarelkin S. A., Pearton S. J. Deep trap analysis in green light emitting diodes: Problems and solutions // Journal of Applied Physics. 2019. Vol. 125. No. 21. p. 215701. 6. Polyakov A. V., Alexanyan L. A., Skorikov M. L., Chernykh A. M., Shchemerov I. V., Murashev V., Kim T., Lee I. C., Pearton S. J. Post dry etching treatment of nanopillar GaN/InGaN multi-quantum wells // Journal of Alloys and Compounds. 2021. Vol. 868. p. 159211. 7. Polyakov A. Y., Vasilev A., Kochkova A. I., Shchemerov I. V., Yakimov E. B., Miakonkikh A. V., Chernykh A. V., Lagov P., Pavlov Yu. S., Doroshkevich A., Isaev R. S., Romanov A. A., Alexanyan L. A., Matros N., Azarov A., Kuznetsov A., Pearton S. J. Proton Damage Effects in Double Polymorph γ/β-Ga₂O₃ Diodes // Journal of Materials Chemistry C. 2024. Vol. 12. No. 3. pp. 1020-1029.
Индекс Хирша по Scopus Количество статей Scopus SPIN РИНЦ ORCID ResearcherID Scopus AuthorID	8 19 9887-1739 0000-0001-7972-2003 GWZ-7777-2022 57208018546
Научное руководство/ Преподавание	Ведение лабораторных работ по дисциплинам: - Физика конденсированного состояния - Физика полупроводников